

課題番号 : F-17-UT-0012
利用形態 : 機器利用
利用課題名(日本語) : ナノインプリントにおける大面積・超微細加工の研究開発プロジェクト
Program Title (English) : Study of large-area, nanostructure fabrication with nanoimprint technology
利用者名(日本語) : 須崎泰正、坂森重則
Username (English) : Y. Suzaki and S. Sakamori
所属名(日本語) : SCIVAX 株式会社
Affiliation (English) : SCIVAX Co. Ltd.
キーワード/Keyword : リソグラフィ・露光・描画装置、ナノインプリント、大面積

1. 概要(Summary)

近年、さまざまなデバイスにおいて性能向上や集積化のために微細加工技術の必要性が増している。従来の光学系を用いた光リソグラフィ技術では、g/i 線ステップ技術、液浸露光技術を併用した KrF/ArF 露光技術、さらに最近では極短波長の紫外線を用いた EUV 露光技術により、1Xnm までの超微細化が進んでいる。また電子線を用いた EB 露光では数十 nm レベルでの超微細パターン形成が実現されている。

一方、全く異なるアプローチとしてナノインプリント技術が注目されている。ナノインプリントは精巧に作製された金型(モールド)若しくは、その金型から複製された金型(レプリカモールド)を用いて、モールドをレジストや UV 硬化樹脂などの被転写材料に直接、押し付けて、ナノメートルオーダーのパターンを等倍で転写する技術である。

ナノインプリント技術は、1995 年に米国プリンストン大学の Chou らがナノメートルオーダーの微細加工を発表して以来、主に熱可塑性材料を用いた熱インプリントと UV 硬化樹脂材料を用いた UV インプリントが研究開発されている。またナノインプリントは光や電子線によるパターンニングとは異なり、モールドの超微細パターンを直接、基材に接触させて加工するのでレンズ収差などの光学系の制約を受けず、モールドを大面積化できれば、比較的容易に数百 mm から 1 m 角以上の大面積への一括成型が可能となる。そこで本研究では、ナノインプリントで利用可能な大面積で超微細パターンを持ったモールドを実現するため、東大ナノテクプラットフォームの非常に高性能な EB 描画技術とドライエッチング技術を用いて、その有用性を検討している。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

高速大面積電子線描画装置(東京大学)

塩素系 ICP エッチング装置(東京大学)

【実験方法】

昨年度までに検討した作製条件を基に、より微細なパターンを 8 インチシリコン基板に対して、EB 描画にて CP モードで直接描画した後、ドライエッチングを用いてパターンニングを実施した。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

上記で作製した 8 インチシリコン基板を Fig. 1 に示す。50 mmφの領域に 200 nm ピッチで 150 nmφのホールパターンが CP モードで描画されており、描画時間は約 40 時間であった。昨年度に比べて描画面積は縮小したものの描画パターンはより微細、かつ高密度になっている。今後、面内均一性、描画つなぎ精度などモールドに必要な要件を評価して、装置の描画安定性を確認する予定である。



Fig. 1 Photo of Si mold.

4. その他・特記事項(Others)

上記装置利用および条件出しについて多大なご協力、ご助言を頂いた澤村支援員に感謝いたします。

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし

6. 関連特許(Patent)

なし